

LAPT

2SA1295

シリコンPNPエピタキシャルプレーナ型トランジスタ (2SC3264とコンプリメンタリ)

用途: オーディオ、一般用

■絶対最大定格 (Ta=25)

記号	規格値	単位
V _{CB0}	- 230	V
V _{CEO}	- 230	V
V _{EB0}	- 5	V
I _C	- 17	A
I _B	- 5	A
P _C	200(T _C = 25)	W
T _J	150	
T _{stg}	- 55 ~ + 150	

■電気的特性 (Ta=25)

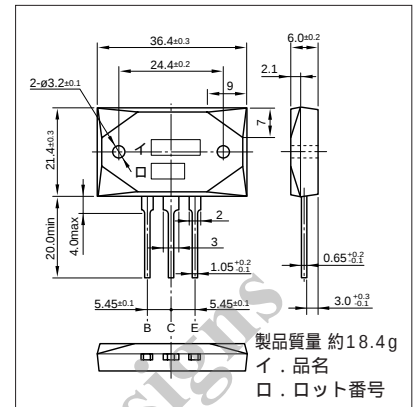
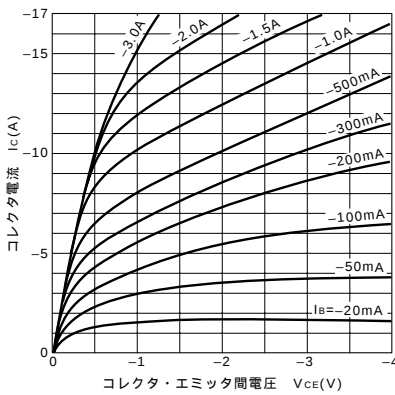
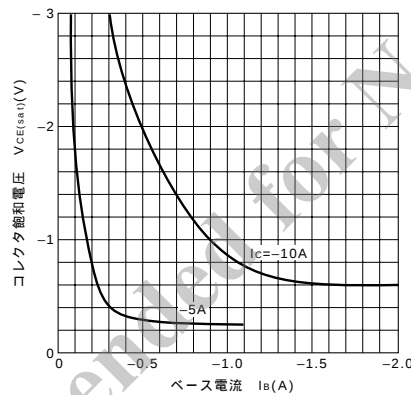
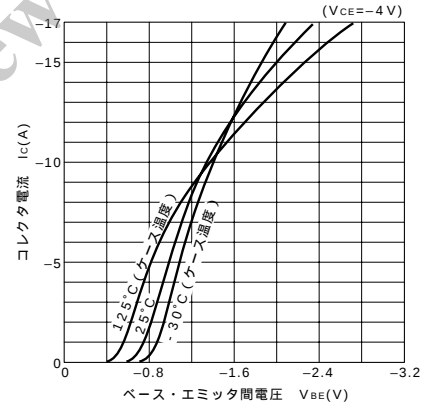
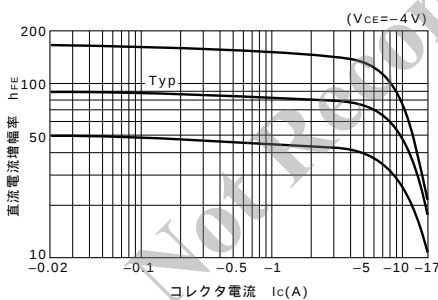
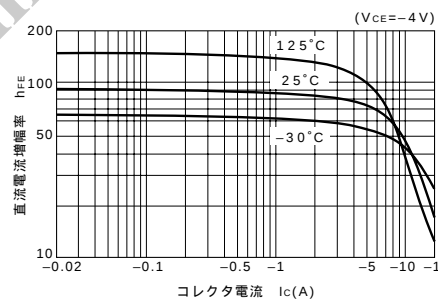
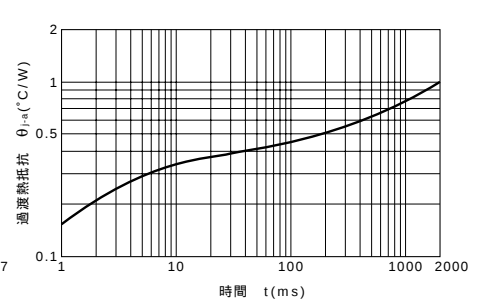
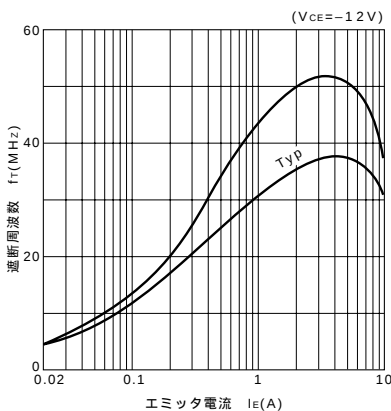
記号	試験条件	規格値	単位
I _{CB0}	V _{CB} = - 230V	- 100max	μA
I _{EB0}	V _{EB} = - 5V	- 100max	μA
V _{(BR)CEO}	I _C = - 25mA	- 230min	V
h _{FE}	V _{CE} = - 4V, I _C = - 5A	50min	
V _{CE(sat)}	I _C = - 5A, I _B = - 0.5A	- 2.0max	V
f _T	V _{CE} = - 12V, I _E = 2A	35typ	MHz
C _{OB}	V _{CB} = - 10V, f = 1MHz	500typ	pF

ランク O(50~100), Y(70~140)

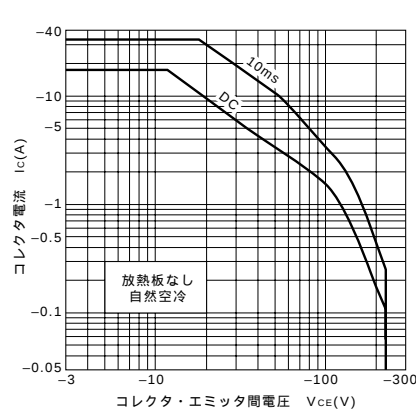
■代表的スイッチング特性 (エミッタ接地)

V _{CC} (V)	R _L (Ω)	I _C (A)	V _{BB1} (V)	V _{BB2} (V)	I _{B1} (mA)	I _{B2} (mA)	t _{on} (μs)	t _{stg} (μs)	t _f (μs)
-60	12	-5	-10	5	-500	500	0.35typ	1.50typ	0.30typ

外形図 MT-200

I_C-V_{CE}特性 (代表例)V_{CE(sat)}-I_B特性 (代表例)I_C-V_{BE}温度特性 (代表例)h_{FE}-I_C特性 (代表例)h_{FE}-I_C温度特性 (代表例)θ_{j-a}-t特性f_T-I_E特性 (代表例)

ASO曲線 (単発パルス)

P_C-T_a定格